

하이닉스, 도시바와 M램 공동개발

STT-M램 공동생산도 ... 저전력 · 비휘발성 장점 살려 PC · 서버 공략

하이닉스반도체는 일본 도시바(Toshiba)와 핵심 차세대 메모리 STT-M램 공동개발 및 합작기업 설립을 통한 공동생산 계약을 체결했으며, 종전 특허 상호 라이선스 및 공급계약 연장에도 합의했다고 7월13일 발표했다.

하이닉스는 M램 공동개발이 차세대 유망기술 분야에 대한 세계 반도체 선도기업의 협력이라는 점에서 성공 가능성이 높다고 평가했다.

세계 반도체 시장점유율 3위인 도시바는 M램 기술 및 개발능력 면에서 최고 경쟁력을 갖춘 것으로 알려졌고, 하이닉스는 최고수준의 메모리 반도체 기술과 원가 경쟁력을 갖추고 있기 때문이다.

M램은 초고속 및 저전력으로 작동하고 전력 공급 없이도 데이터를 보관하는 비휘발성의 장점과 함께 안정성 등을 두루 갖춘 차세대 메모리로, 기술적 한계로 여겨지는 10나노 이하에서도 집적이 가능하다.

양사는 M램으로 초기에는 저전력 특성을 기반으로 한 모바일 시장에 진입한 후 중장기적으로 PC 및 서버 시장까지 공략할 방침이다.

하이닉스반도체 권오철 사장은 “M램은 빠른 동작 속도와 낮은 전력 소비, 높은 신뢰성 등의 기존 메모리의 장점을 두루 갖춰 새로운 모바일 기기 수요 확대와 고성능이 요구되는 메모리에 최적화된 제품”이라고 강조했다.

도시바의 반도체 부문 Kobayashi 사장도 “M램은 공정 미세화에 유리해 향후 성공 가능성이 매우 크다”며 “M램, NAND Flash, HDD(Hard Disk Drive) 등을 포함한 모든 Storage Solution 제공을 목표로 하이닉스와 공동개발에 나설 것”이라고 말했다.

양사는 기술적 장점과 자원을 최대한 활용해 개발 위험을 줄이는 한편 M램의 상용화 시기를 앞당길 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또한 포괄적 제휴를 통해 양사가 공동 개발한 M램 제품은 합작사를 설립해 공동 생산함으로써 투자비를 균등하게 분담하고 투자 위험을 축소하여 효율성을 높일 계획이다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2011/07/13>